

产品特点

高精度贴片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

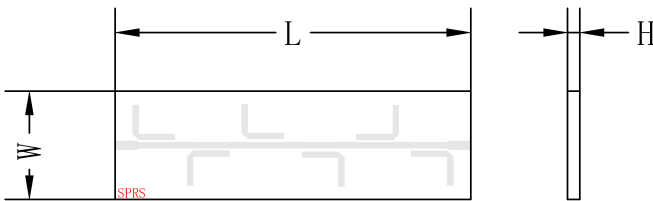
技术要求

项目	参数	单位
通带频率	DC-3.8	GHz
通带频率	4.8-18.0	GHz
通带损耗	3.0	dB
带内波动	3.0	dB
驻波比	2.0:1	
群时延波动	1.5	ns
阻带抑制	40@4.3GHz	dBc

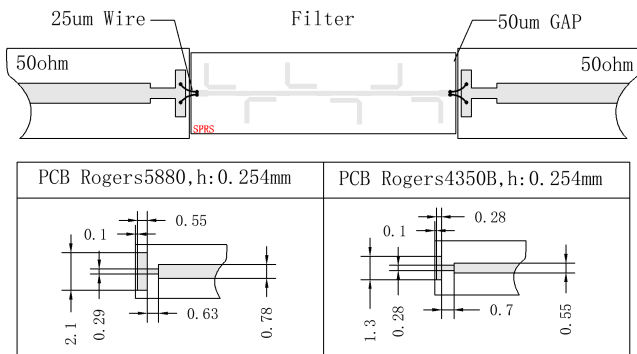
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85°C
储存温度	-55 ~ +125°C
外形尺寸	L : 13.9 , W : 4.0 , h : 0.26

外形图：端口居中



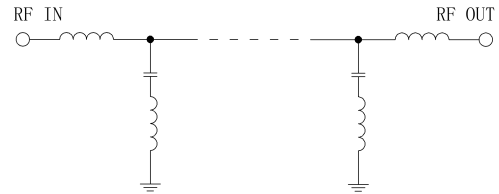
推荐装配图



注意事项

- 1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
- 2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
- 3：芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 ≥ 0.2mm;
- 4：微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线

